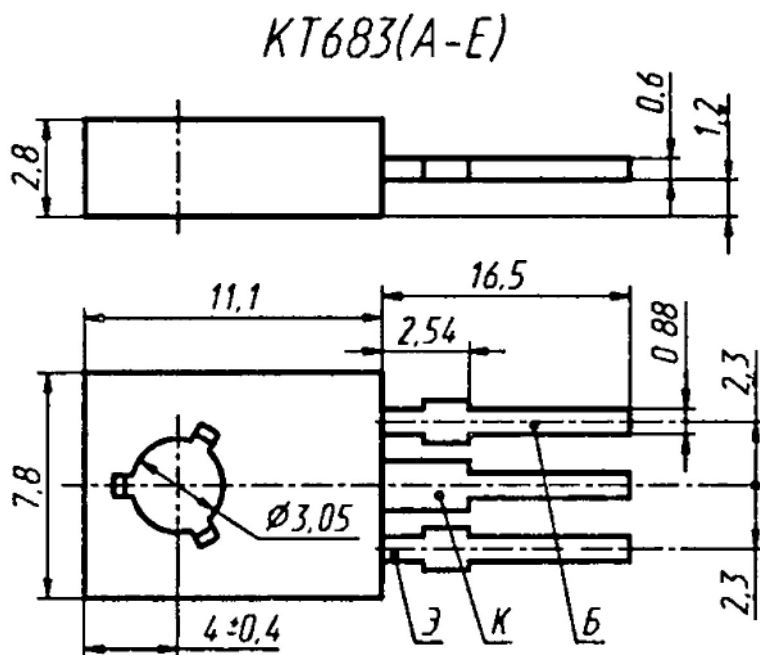


КТ683А, КТ683Б, КТ683В, КТ683Г, КТ683Д, КТ683Е

Транзисторы кремниевые планарные структуры *n-p-n* универсальные. Предназначены для применения в усилителях и переключающих устройствах. Выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 1 г.



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока
в схеме ОЭ при $U_{кэ} = 10$ В, $I_k = 0,15$ А:

КТ683А, КТ683В, КТ683Г	40...120
КТ683Б, КТ683Д	80...240
КТ683Е	160...480

Граничная частота коэффициента передачи
тока в схеме ОЭ при $U_{кб} = 10$ В, $I_3 = 50$ мА,
не менее

50 МГц

Граничное напряжение при $I_3 = 30$ мА,
не менее:

КТ683А	90 В
КТ683Б, КТ683В	80 В
КТ683Г	60 В
КТ683Д, КТ683Е	40 В

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер

при $I_k = 0,15$ А, $I_б = 15$ мА, не более

0,45 В

Напряжение насыщения база—эмиттер

при $I_k = 0,15$ А, $I_б = 15$ мА, не более

1 В

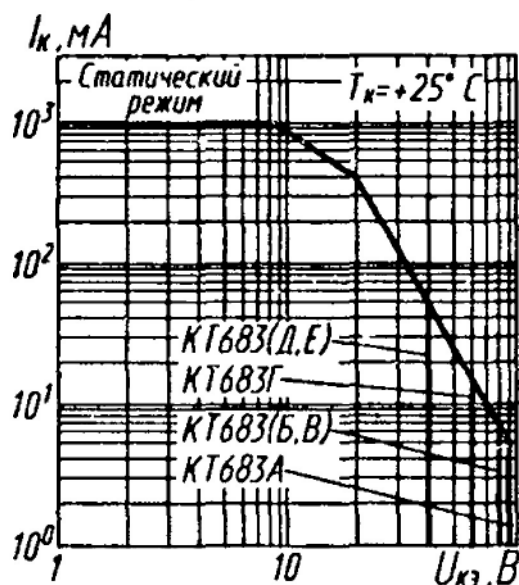
Пробивное напряжение коллектор—эмиттер	
при $I_k = 0,1$ мА, $R_{БЭ} = 3$ кОм, не менее:	
КТ683А	150 В
КТ683Б, КТ683В	120 В
КТ683Г	100 В
КТ683Д, КТ683Е	60 В
Пробивное напряжение база—эмиттер	
при $I_3 = 0,1$ мА, не менее:	
КТ683А, КТ683Б, КТ683В	7 В
КТ683Г, КТ683Д, КТ683Е	5 В
Время включения при $U_{кэ} = 40$ В, $I_k = 0,2$ А, $I_Б = 40$ мА, типовое значение	0,1* мкс
Время выключения при $U_{кэ} = 40$ В, $I_k = 0,2$ А, $I_Б = 40$ мА, типовое значение	0,2* мкс
Емкость коллекторного перехода	
при $U_{кб} = 10$ В, не более	15* пФ
Емкость эмиттерного перехода	
при $U_{зб} = 0,5$ В, не более	65* пФ
Обратный ток коллектора при $U_{кб} = 90$ В для КТ683А, КТ683Б, КТ683В и 40 В для КТ683Г, КТ683Д, КТ683Е, не более	1 мкА

Предельные эксплуатационные данные

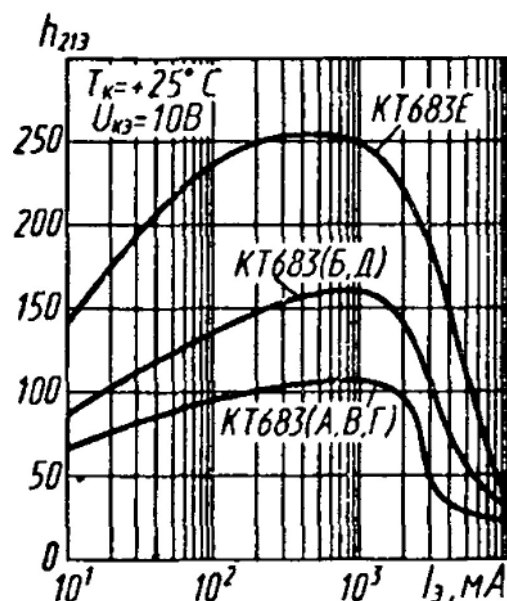
Постоянное напряжение коллектор—база:	
КТ683А	150 В
КТ683Б, КТ683В	120 В
КТ683Г	100 В
КТ683Д, КТ683Е	60 В
Постоянное напряжение коллектор—эмиттер:	
при $R_{БЭ} = 3$ кОм:	
КТ683А	150 В
КТ683Б, КТ683В	120 В
КТ683Г	100 В
КТ683Д, КТ683Е	60 В
при $R_{БЭ} = \infty$:	
КТ683А	90 В
КТ683Б, КТ683В	80 В
КТ683Г	60 В
КТ683Д, КТ683Е	40 В
Постоянное напряжение база—эмиттер:	
КТ683А, КТ683Б, КТ683В	7 В
КТ683Г, КТ683Д, КТ683Е	5 В

Постоянный ток коллектора	1 А
Импульсный ток коллектора при $t_{и} = 1$ мс.....	2 А
Постоянный ток базы	0,2 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора ¹ при $T_{к} = -60...+25$ °С:	
с теплоотводом	8 Вт
без теплоотвода	1,2 Вт
Температура р-п перехода	+150 °С
Температура окружающей среды	-60... $T_{к} =$ = +125 °С

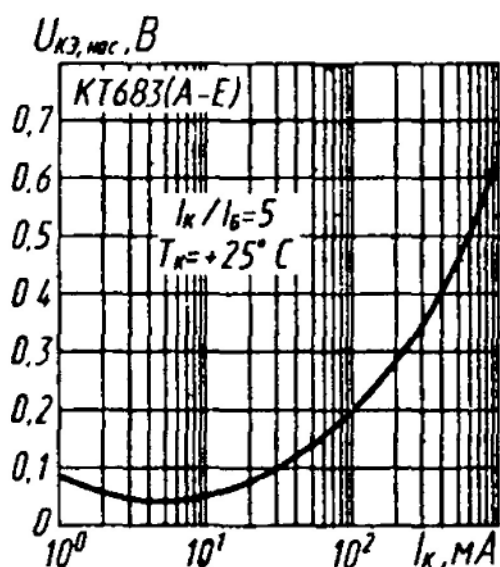
¹ При $T_{к} \geq 25$ °С $P_{к, макс}$ снижается линейно на 0,064 Вт/°С с теплоотводом и на 0,0096 Вт/°С без теплоотвода.



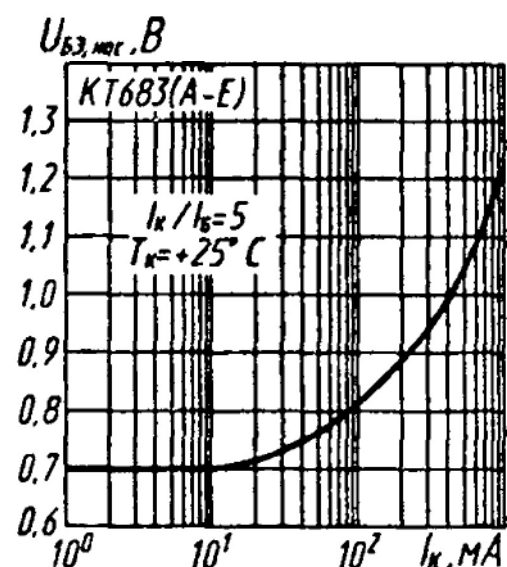
Области безопасной работы транзисторов



Зависимости статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



Зависимость напряжения насыщения коллектор—эмиттер от тока коллектора



Зависимость напряжения насыщения база—эмиттер от тока коллектора